2SA661

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ（PCT方式）
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR(PCT PROCESS)

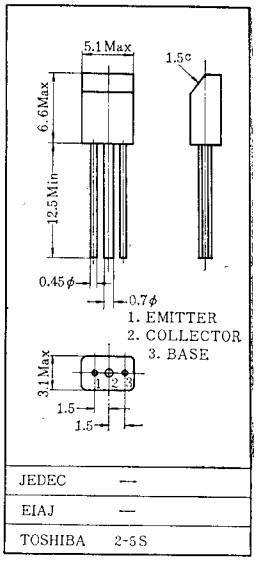
○励振段増幅用　○電圧増幅用

○ Driver Stage and Amplifier Applications.

○ High Voltage Amplifier Applications.

- 高耐圧です：$V_{CEO} \geqq -50V$
- 許容コレクタ損失が大きい：$P_C = 600mW$ (Ta=25°C)
- 2SC1166とコンプリメンタリになります.
- Complementary to 2SC1166

Unit in mm



JEDEC	—
EIAJ	—
TOSHIBA	2-5S

アクセサリはRH-16を適用
RADIATOR HOLDER RH-16

最大定格　MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	− 5	V
コレクタ電流	I_C	−200	mA
エミッタ電流	I_E	200	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	−55～150	°C

電気的特性　ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-20V$, $I_E=0$	—	—	−100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V$, $I_C=0$	—	—	−100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10mA$, $I_B=0$	−50	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.1mA$, $I_B=0$	− 5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2V$, $I_C=-50mA$	40	100	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2V$, $I_C=-200mA$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-100mA$, $I_B=-10mA$	—	—	−0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-2V$, $I_C=-200mA$	—	—	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-10V$, $I_E=10mA$	70	100	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10V$, $I_E=0$, f=1MHz	—	9	—	pF

Note；$h_{FE(1)}$により下表のように分類し，現品表示してあります.

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA661 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA661—R	40	80
2SA661—O	70	140
2SA661—Y	120	240
2SA661—GR	200	400

P_C – Ta

